

## Kurzbeschreibung

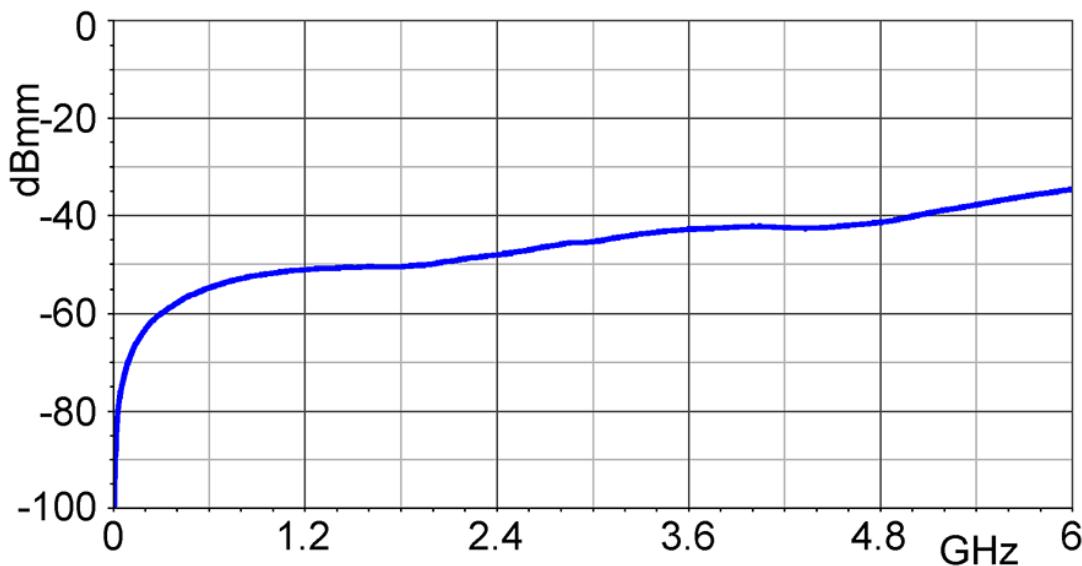
Die Elektrode in der Unterseite des Sondenkopfes der Scannersonde XFS-E 10 ist ca. 0,2 mm breit. Damit können kleinste E-Feldquellen lokalisiert werden, z.B. 0,1 mm breite Leiterzüge, einzelne IC-Pins an hochpoligen ICs. Zur Messung wird die E-Feldsonde auf das Messobjekt aufgesetzt.

Die XFS-E 10 ist eine passive Nahfeldsonde. Typischerweise wird der Sondenkopf direkt auf das Messobjekt aufgesetzt (hohe elektrische Feldstärke). Die Nahfeldsonde hat eine Mantelstromdämpfung und ihre Oberseite ist elektrisch geschirmt. Sie wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit  $50 \Omega$  Eingang angeschlossen. Die E-Feldscannersonde besitzt intern einen Abschlusswiderstand.

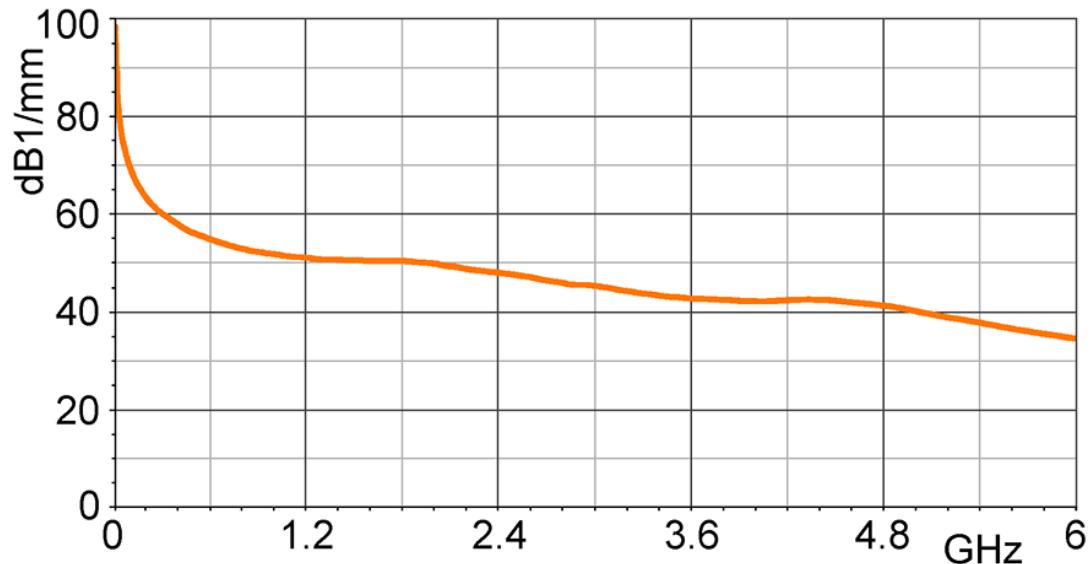
## Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 6 GHz
Auflösung	≈ 0.2 mm
Maße Sondenkopf:	≈ (0.5 x 2) mm
Anschluss - Ausgang	SMA, male, jack

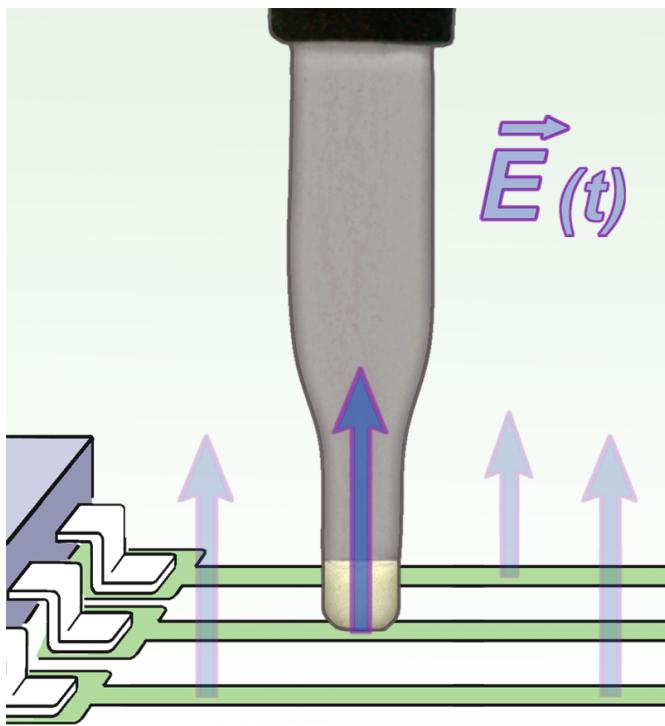
Frequenzgang [ $\text{dB}\mu\text{V}$ ] / [ $\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$ ]



Korrekturkurve E-Feld [dB $\mu$ V/mm] / [dB $\mu$ V]



Messprinzip



# XFS-E 10

Scannersonde 30 MHz bis 6 GHz

**LANGER**  
EMV-Technik

